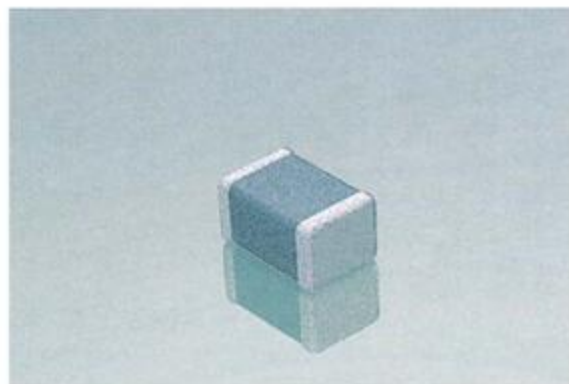


一般特定网络阳离子



COG (NP0) 是最常见配方

“温度补偿” EIA I类陶瓷材料。现代COG (NP0) 配方中含有钽, 铈和其它稀土氧化物。

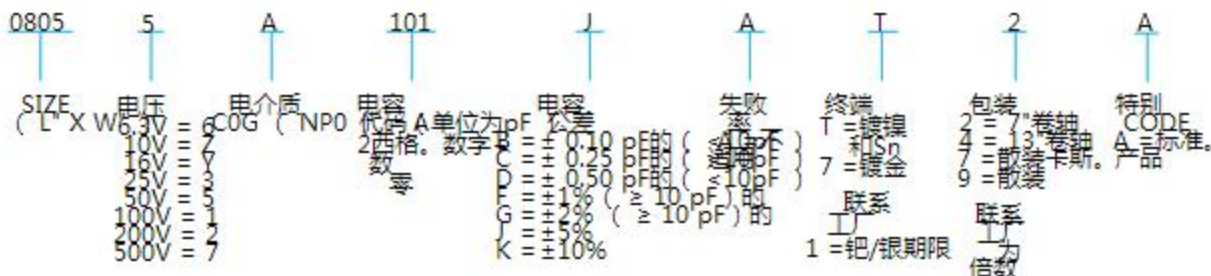
COG (NP0) 陶瓷提供最稳定的电容器之一可用介质。电容随温度的变化

为 $0 \pm 30 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 的 $\pm 0.3\%$ C 从 -55°C 至 $+125^\circ\text{C}$ 。电容的漂移或滞后COG (NP0)

陶瓷是可忽略的, 在小于 $\pm 0.05\%$ 和高达 $\pm 2\%$ 的薄膜。典型的电容变化的生活少

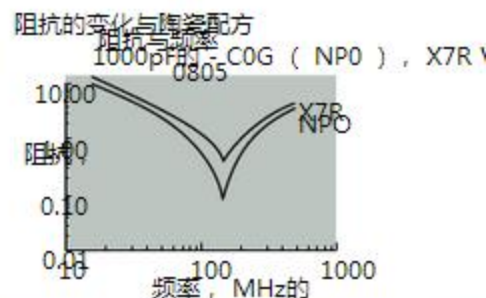
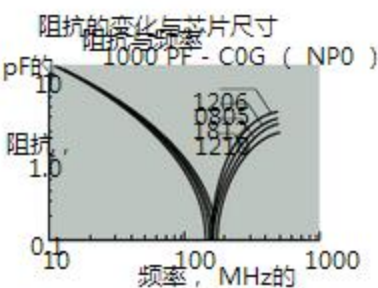
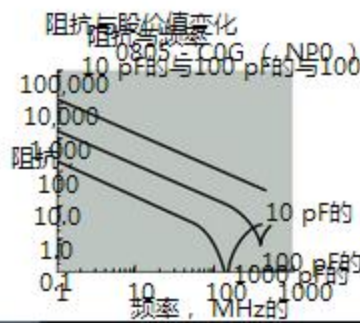
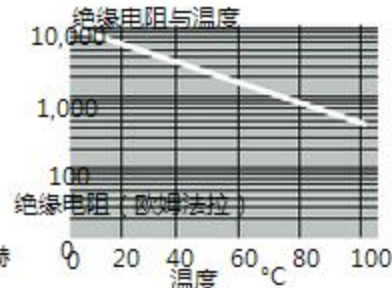
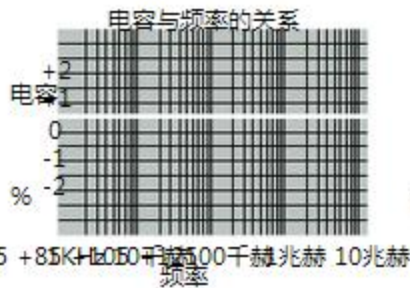
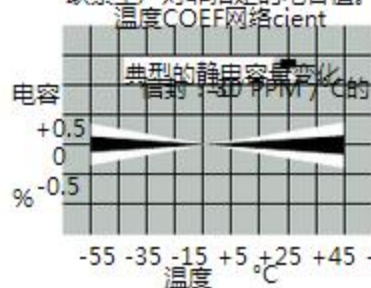
超过 \pm 为COG (NP0) 0.1%, 五分之一, 所示由其他的电介质。COG (NP0) 配方中不显示衰老的特点。

部件号 (见完整的零件号解释第2页)



注: 请联系工厂对特定的型号终止与宽容选项的可用性。

联系工厂对非指定的电容值。



参数/测试		NPO规格限制	测量条件
工作温度范围	电容	-55°C至+125°C	温度循环室
	Q	在特定网络版公差 <30 PF: $Q \geq 400 + 20 \times \text{股价值}$ $\geq 30 \text{ PF} + Q \geq 1000$	频率: 1.0 MHz的±10%的上限≤1000 pF的 1.0千赫±10%的上限>1000 pF的
绝缘电阻		100,000MΩ或1000MΩ·μF, 以较低者为准	充电设备的额定电压 60±5秒@室内温度/温度
介电强度		无击穿或视觉缺损	充电装置,用300%的额定电压的供 1-5秒,瓦特/充电和放电电流 限定到50mA(最大) 注:为额定150%充电装置 电压为500V的设备。 变形:2毫米 测试时间:30秒
耐弯曲	外形 电容 变异	无缺陷 ±5%或±0.5 pF的,以较高者为准	
	Q	满足初始值(如上面)	
	绝缘 阻力	≥初始值×0.3	
可焊性		每个终端≥95%应覆盖 用新鲜的焊锡	浸在共晶焊料在230±5°C的设备 为5.0±0.5秒
耐焊锡热	外形 电容 变异	无缺陷,两端端子<25%浸出% ≤±2.5%或±0.25 pF的,以较高者为准	在共晶焊料在260°C进行60 DIP设备 秒。储存在室温24±2 测量电气性能之前小时。
	Q	满足初始值(如上面)	
	绝缘 阻力	满足初始值(如上面)	
	电介质 实力	满足初始值(如上面)	
热震	外形 电容 变异	没有视觉缺陷 ≤±2.5%或±0.25 pF的,以较高者为准	第1步: -55°C ± 2° 30±3分钟 第2步: 房间温度 ≤3分钟
	Q	满足初始值(如上面)	步骤3: +125°C ±3° ±3分钟
	绝缘 阻力	满足初始值(如上面)	步骤4: 房间温度 ≤3分钟
	电介质 实力	满足初始值(如上面)	重复5次和措施后, 在室温下24小时
负载寿命	外形 电容 变异	没有视觉缺陷 ≤±3.0%或±0.3 pF的,以较高者为准	充电设备与二次额定电压 试验室设在125°C ± 2°C 1000小时(48, -0)。 从试验容器中取出,并稳定在 室温下进行24小时 前测。
	Q (C=额定章)	≥30 pF的 $Q \geq 350$ ≥10 PF, <30 PF ≥ +275°C/2 <10 PF + Q ≥ 200 + 10°C	
	绝缘 阻力	≥初始值×0.3(见上文)	
	电介质 实力	满足初始值(如上面)	
负载湿度	外形 电容 变异	没有视觉缺陷 ≤±5.0%或±0.5 pF的,以较高者为准	存放在试验室设在85°C ± 2°C / 1000小时85%±5%相对湿度 (48, -0)额定电压应用。 从室中取出,并稳定在 室温下放置24±2小时 前测。
	Q	≥30 pF的 $Q \geq 350$ ≥10 PF, <30 PF ≥ +275°C/2 <10 PF + Q ≥ 200 + 10°C	
	绝缘 阻力	≥初始值×0.3(见上文)	
		电介质 实力	满足初始值(如上面)